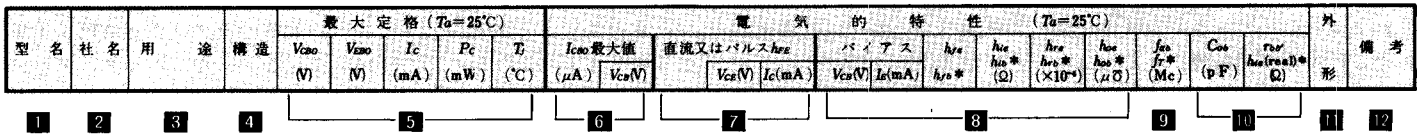
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

:とコンプリ: COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)		
2SA953	日電	AF.PA	Si.E	−60	−5	−300	600	150	−0.1	−60	200	−1	−50	−6	10					100*	13		138	2SC2002とコンプリ
〃 954	〃	〃	〃	−80	−5	−300	600	150	−0.1	−80	200	−1	−50	−6	10					100*	13		138	2SC2003とコンプリ
〃 955																								
〃 956	日電	RF.AF.SW	Si.E	−60	−8	−100	150	125	−0.1	−40	160	−1	−10	−10	10	t_{on}=100nS, t_{off}=270nS t_{stg}=200nS				280*	7.5		176	
〃 957	サンケン	PA	Si.EMe	−150	−6	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−150	100	−10	−0.7A	−12	200					20*	35	35	298	
〃 958	〃	〃	〃	−200	−6	−2A	30W (Tc=25°C)	150	−100	−200	100	−10	−0.7A	−12	200					20*	35	35	298	
〃 959	日電	SW	Si.E	−100	−7	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	30~200	−5	−5A			t_{on}<1 μS, t_f<0.3μS t_{stg}<1.5μS							102	
〃 960																								
〃 961																								
〃 962	東芝	PA	Si.E	−60	−5	−1.5A	1 W	150	−1	−50	70~240	−2	−150	−10	100					100*	30		249	2SC2194とコンプリ
〃 963	松下	〃	Si.EP	−50	−5	−1.5A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	120	−5	−1A	−5	500					150*	45	3.3k*	236	
★ 〃 964	日電	〃	Si.E	−200	−5	−200	10W (Tc=25°C)	150	−1	−180	180	−10	−10	−10	10					100*	3	16*	167C	
〃 965	東芝	AF	〃	−120	−5	−800	900	150	−0.1	−120	80~240	−5	−100	−5	100					120*	<40	40	241	2SC2235とコンプリ
〃 966	〃	PA	〃	−30	−5	−1.5A	900	150	−0.1	−30	100~320	−2	−500	−2	500					120*	<30		241	2SC2236とコンプリ
〃 967																								
〃 968	東芝	PA	Si.E	−160	−5	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100*	30		268	2SC2238とコンプリ
〃 969	〃	〃	〃	−160	−5	−1.5A	25W (Tc=25°C)	150	−1	−160	70~240	−5	−100	−10	100					100*	30		99	2SC2239とコンプリ
〃 970	〃	AF.LN	〃	−120	−5	−100	300	125	−0.1	−120	200~700	−6	−1	−6	1	NF< 6 dB (f=10Hz, 6V, 100μA) NF< 2 dB (f=1kHz)				100*	4		138	
〃 971	サンケン	PA	Si.EMe	−150	−6	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−150	60	−4	−5A	−12	500					10*	270	18*	102	
〃 972	松下	AF	Si.EP	−30	−7	−100	250	135	−1	−10	250	−10	−2	−10	2					150*	5.5		138	
〃 973	〃	RF	〃	−60	−5	−50	250	125	−0.1	−30	500	−5	−2	−10	1					70*	15	9.5k*	138	
〃 974																								
〃 975																								
〃 976																								
〃 977	松下	PA	Si.EP	−180	−5	−50	1 W	150	−1	−100	180	−5	−10	−10	10					80*	3.5	50	222	
〃 978	三菱	AF.LN.RF	〃	−40	−5	−100	200	125	−0.1	−35	150~1200	−6	−1	−6	10	V_{NO}<300mV (10V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				125*	13	13	138B	
〃 979	〃	LN.Diff	〃	−100	−5	−50	200/unit	125	−0.1	−70	250~1200	−6	−1	−6	1	ΔV_{BE}<10mV h_{FE1}/h_{FE2}=0.8~1.0				150*	2.5		274A	2素子複合
〃 980	サンケン	PA	Si.TMe	−100	−6	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−100	>30	−4	−3A	−12	500					20*			102	2SC2260とコンプリ
〃 981	〃	〃	〃	−120	−6	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−120	>30	−4	−3A	−12	500					20*			102	2SC2261とコンプリ
〃 982	〃	〃	〃	−140	−6	−8A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−140	>30	−4	−3A	−12	500					20*			102	2SC2262とコンプリ